

Содержание

● Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Король В.М., Заставной А.В., Kudriavtsev Y., Asomoza R.

Отрицательный отжиг в кремнии при высоковольтной имплантации натрия 579

● Электронные свойства полупроводников

Джахангирли З.А., Керимова Т.Г., Абдуллаев Н.А., Мамедова И.А., Мамедов Н.Т.

Расчеты из первых принципов дисперсии фононов в CdGa_2Se_4 585

Мездригина М.М., Виноградов А.Я., Левицкий В.С., Терукова Е.И., Кожанова Ю.В., Агликов А.С.

Параметры пленок ZnO с дырочным типом проводимости, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления 588

Агеева Н.Н., Бронева И.Л., Забегаев Д.Н., Кривоносов А.Н.

Пикосекундная релаксация перенормировки запрещенной зоны GaAs, вызванной кулоновским взаимодействием носителей заряда 594

● Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Ницук Ю.А., Ваксман Ю.Ф.

Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов $\text{ZnSe}:\text{Ti}$ 600

Зарубанов А.А., Плюснин В.Ф., Журавлев К.С.

Передача электронного возбуждения из органической матрицы в нанокристаллы CdS, полученные методом Ленгмюра Блоджетт 605

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Власов А.С., Карлина Л.Б., Комисаренко Ф.Э., Анкудинов А.В.

Модификация поверхности GaAs и наблюдение эффекта гигантского рамановского рассеяния после диффузии индия 611

Матюшкин Л.Б., Решетникова А.А., Андронов А.О., Афоничева П.К., Мякин С.В., Пермьяков Н.В., Мошников В.А.

Морфология, оптические и адсорбционные свойства слоев оксидов меди, осажденных из растворов комплексных соединений 615

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Аскеров Ш.Г., Абдуллаева Л.К., Гасанов М.Г.

Причина расхождения экспериментальных значений высоты барьера на контакте металл–полупроводник 620

Пашковский А.Б.

Особенности баллистического транспорта электронов через открытые двухуровневые системы в сильном высокочастотном электрическом поле 623

Захарьин А.О., Васильев Ю.Б., Соболев Н.А., Забродский В.В., Егоров С.В., Андрианов А.В.

Инжекционная терагерцовая электролюминесценция кремниевых p – n –структур 632

Кононов Н.Н., Дорофеев С.Г.

Характеристики барьеров Шоттки тонкопленочных, двух-контактных структур Al/пленка из наночастиц Si/ITO . . . 637

Басалаев Ю.М., Малышева Е.Н.

Электронное строение монослойных сверхрешеток $(\text{GeC})_1(\text{SiC})_1$, $(\text{SnC})_1(\text{SiC})_1$ и $(\text{SnC})_1(\text{GeC})_1$ 647

Гращенко А.С., Феоктистов Н.А., Осипов А.В., Калинин Е.В., Кукушкин С.А.

Фотоэлектрические характеристики структур карбид кремния–кремний, выращенных методом замещения атомов в кристаллической решетке кремния 651

● Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Курочкин Н.С., Кацаба А.В., Амброзевич С.А., Витухновский А.Г., Ващенко А.А., Тананаев П.Н.

Передача электронного возбуждения от TPD к нанокристаллам CdSe/CdS/ZnS 659

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Исмаилов Н.Д., Абилов Ч.И., Гасанова М.С.

О фотопроводимости TlInSe_2 663

● Углеродные системы

Подливаев А.И., Опенов Л.А.

Влияние десорбции водорода на механические свойства и электронную структуру алмазоподобных углеродных нанониток 667

Давыдов С.Ю.

Влияние интеркалированного водорода на электронное состояние квазисвободного графена на подложке SiC . . 671

**Хвостиков В.П., Сорокина С.В., Потапович Н.С.,
Хвостикова О.А., Тимошина Н.Х.**

Фотоэлектрический приемник лазерного излучения
(λ 809 нм) на основе GaAs 676

Гусев А.И., Любутич С.К., Рукин С.Н., Цыранов С.Н.

Исследование процесса спада напряжения при ударно-ионизационном переключении силовых тиристоров . . . 680

**Сенокосов Э.А., Чукича В.И., Хамидуллин Р.А.,
Чебан В.Н., Один И.Н., Чукичев М.В.**

Экспериментальное и теоретическое исследования характеристик позиционно-чувствительных фотоприемников на основе эпитаксиальных слоев n -CdSc/слюда 689

Алешкин В.Я., Байдусь Н.В., Дубинов А.А., Красильник З.Ф., Некоркин С.М., Новиков А.В., Рыков А.В., Юрасов Д.В., Яблонский А.Н.

Стимулированное излучение лазерных структур InGaAs/GaAs/AlGaAs, выращенных методом газовой фазной эпитаксии из металлоорганических соединений на неотклоненной и отклоненной подложках Ge/Si(001) 695

**Карлина Л.Б., Власов А.С., Бер Б.Я., Казанцев Д.Ю.,
Тимошина Н.Х., Кулагина М.М., Смирнов А.Б.**

Формирование p -эмиттера с участием сурфактантов в GaAs фотоэлектрических преобразователях 699

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

**Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В.,
Надточий А.М., Неведомский В.Н., Жуков А.Е.**

Квантовые точки InAs, выращенные в метаморфной матрице $\text{In}_{0.25}\text{Ga}_{0.75}\text{As}$ методом МОС-гидридной эпитаксии . . . 704

Аннотации статей, поступивших в Редакцию журнала на английском языке. Полные тексты этих статей опубликованы в переводной версии журнала „Физика и техника полупроводников“ — SEMICONDUCTORS

Singh Pravesh, Sharma Sheetal, Kumari Sarita, Saraswat Vibhav K, Sharma D., Verma A.S.

Ab initio studies of structural, electronic, optical, elastic and thermal properties of CuGaTe_2 711